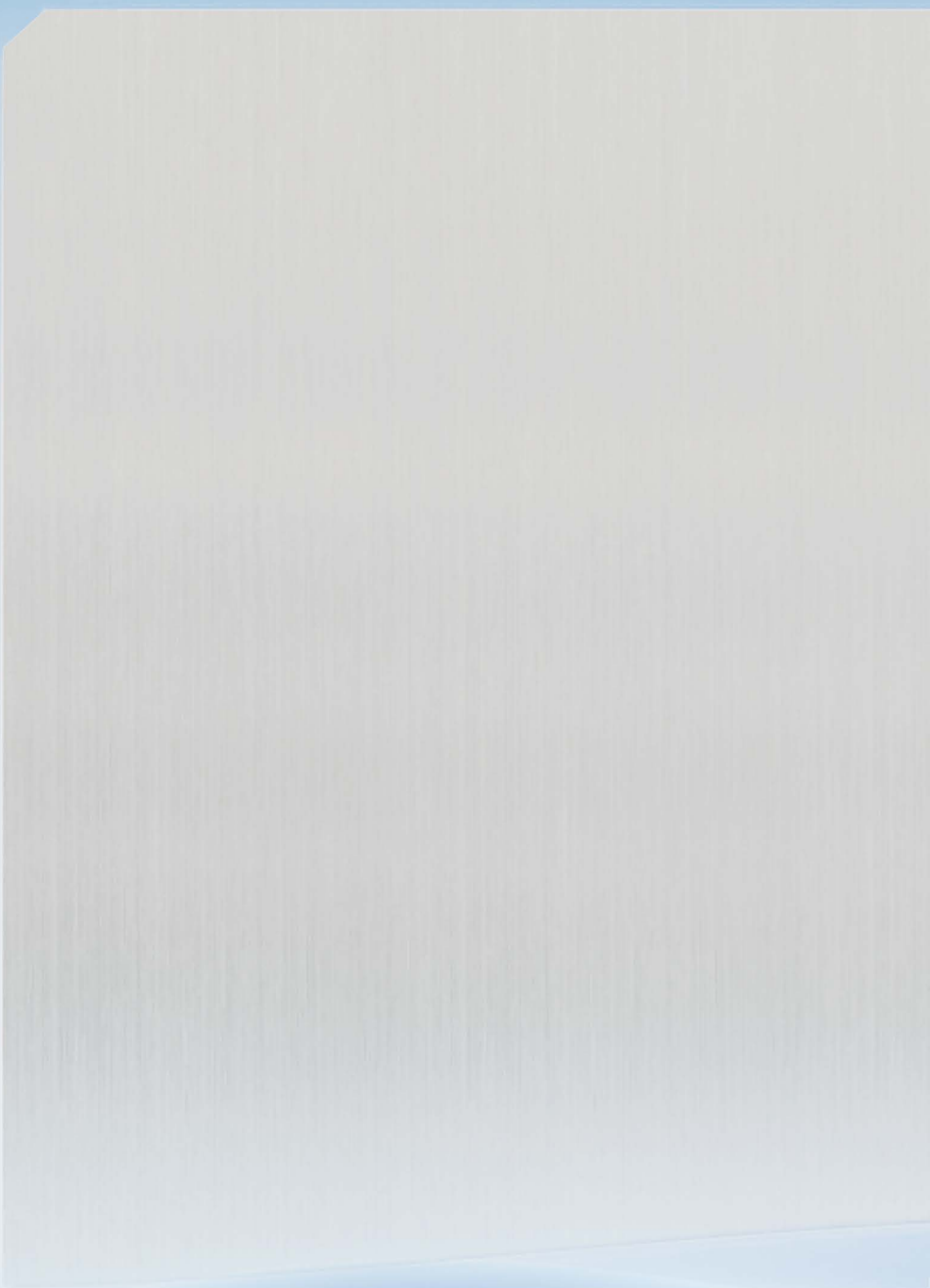


HYSOLAR G12

单晶硅片

N型-G12 / 210*210



弘元新材料（包头）有限公司
地址：包头装备制造产业园区新规划区园区南路1号
网址：www.hysolar.com
邮箱：sales@hysolar.com

■ 关键参数

硅片型号	G12
导电类型	N型
掺杂元素	P (磷)
电阻率	0.4 ~ 1.6Ω • cm
少子寿命	≥1000μs
氧含量	≤12ppma
碳含量	≤1ppma

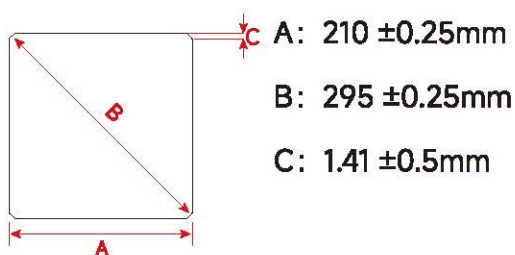
■ 材料性能

生长方式	CZ (直拉) 法
结晶性	单晶
晶向	<100>±2°

■ 几何尺寸及表面性能

倒角边形状	直角
硅片边距	210±0.25mm
硅片对角线	295±0.25mm
厚度	130±10μm
TTV	≤20 μm
线痕	≤13 μm
翘曲度	≤40 μm
切割方式	金刚线切割
表面质量	干净, 无油污、肥皂和胶水等残留物
崩边	深度≤0.3mm,, 长度≤0.5 mm, 不多于两处
裂纹/穿孔	目测不可见

G12 尺寸示意图:



质量管理体系与产品认证:

ISO 50001:2018 ISO 能源管理体系
ISO 9001:2015 ISO 质量管理体系
ISO 14001:2015 ISO 环境管理体系
ISO 45001:2018 ISO 职业健康与安全